

2020年5月18日
一般社団法人 新金属協会
化合物半導体部会
部会長 三浦 浩
JX金属株式会社 薄膜材料事業部
化合物半導体ユニット ユニット長

2019年度通期の化合物半導体の出荷統計について

2019年度通期（2019年4月～2020年3月）の化合物半導体材料の出荷統計がまとまりましたので別紙の通り発表いたします。

2019年度通期（2019年4月～2020年3月）の化合物半導体製品の出荷額は、240億円となりました。結晶別では、GaAs、GaPが減少し、InPが増加致しました。用途別ではその他が増加、可視LED、赤外LED、LDが減少致しました。

1.GaAs

2019度通期のGaAsの売上高は、142億円となり、国内、海外ともに減少しました。GaAsの主な用途市場はスマートフォン等に使用される高周波デバイス、また各種の表示機器やセンサ等に使用される可視・赤外LED、および光ディスク・加工機・センサ等に使用されるレーザダイオード(LD)等がありますが、2019年度の結果は国内外の多くの用途で、需要が減少したことによると推察しています。

2.GaP

2019年度通期のGaPの売上高は、15億円となり、国内、海外ともに減少しました。2019年度は、可視発光LED全体の需要が落ち込みましたが、GaP材料も主に可視発光LED用途が主体であることから、主要な用途である車載、家電等の需要落ち込みが続いていることがと減少の原因と推察されます。更にGaP系から高輝度AlInGaP系やGaN系LEDへの置き換えが徐々に進行していることも要因の一つと推察しています。

3.InP

2019年度通期のInPの売上高は、65億円となり、国内、海外ともに増加しました。主要用途である光通信用の受発光素子の所要が堅調に推移した結果と推察しています。

<お問い合わせ先>
化合物半導体ユニット 主席技師
中村 正志
電話-03-6257-7417 Fax 03-6213-3609
e-mail : nakamura.masashi@384@jxgr.com